

	FQD7N20LTF	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD7N20LTF
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQD7N20LTF.pdf 2.FQD7N20LTF.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 1600 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1600 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5.5A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD7N20LTF ist neu im Original, Suche FQD7N20LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N20LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N20 F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N10TF VB Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD7N20L F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>
 <p>FQD7N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD6N25TM	↔ FQD6N25TM	⇒ FQD6N40C	D FQD6N40CTM	⇒ FQD6N40CTM
⊕ FQD6N50CTF	⊗ FQD6N50CTF	D FQD6N50CTM	⇒ FQD6N50CTM	⇒ FQD6N60C
⊗ FQD6N60CS	⊕ FQD6N60CTF	⊗ FQD6N60CTM	↔ FQD6N60CTM	⇒ FQD6P25TM
D FQD6P25TM	⊗ FQD7N10L	⊕ FQD7N10LTF	⊗ FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTM
⇒ FQD7N10LTM	↔ FQD7N10TF	⊗ FQD7N10TM	⊕ FQD7N10TM	⇒ FQD7N20L
↔ FQD7N20LTF	⇒ FQD7N20LTM	D FQD7N20LTM	⊗ FQD7N20TF	⊕ FQD7N20TF
⊗ FQD7N20TM	D FQD7N20TM	⇒ FQD7N30TM	↔ FQD7N30TM	⇒ FQD7P06TF
⊕ FQD7P06TF	⊗ FQD7P06TM	↔ FQD7P06TM	⇒ FQD7P06TM_F080	⇒ FQD7P06TM_F080
⊗ FQD7P06TM_NB82050	⊕ FQD7P06TM_NB82050	⊗ FQD7P10TF	D FQD7P20TF	⇒ FQD7P20TF
↔ FQD7P20TM	⊗ FQD7P20TM	⊕ FQD7P20TM_F080	⊗ FQD7P20TM_F080	⇒ FQD8P10TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited